
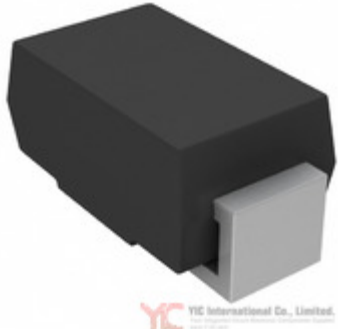


| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: red;">US1BHE3/5AT</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: US1BHE3/5AT</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p> <p>Datenblätter: 1.US1BHE3/5AT.pdf 2.US1BHE3/5AT.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 99000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Teilenummer | US1BHE3/5AT |
| Hersteller | Vishay / Semiconductor - Diodes Division |
| Beschreibung | DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter- |
| Teilstatus | 99000 pcs Stock |
| Serie | - |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | DO-214AC, SMA |
| Supplier Device-Gehäuse | DO-214AC (SMA) |
| Diodentyp | Standard |
| Strom - Richt (Io) | 1A |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 1A |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 10µA @ 100V |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 100V |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 50ns |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -55°C ~ 150°C |
| Kapazität @ Vr, F | 15pF @ 4V, 1MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |

US1BHE3/5AT ist neu im Original, Suche US1BHE3/5AT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie US1BHE3/5AT Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage US1BHE3/5AT: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>US1BFA Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 100V 1A SOD123FA</p> |  <p>US1BHE3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p> |  <p>US1BFA AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 100V 1A SOD123FA</p> |  <p>US1BHE3/61T Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p> |
|  <p>US1BHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE FAST REC 100V 1A DO214AC</p> |  <p>US1BB CITC/ US1BB CITC/</p> |  <p>US1BHE3_A/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE FAST REC 100V 1A DO214AC</p> |  <p>US1BF Original US1BF Original</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| ⊗ US1881ESO | ↔ US1881KSE | ⇒ US1881KSO | D US1881KUA | ↔ US1881KUA-AAA-000-BU |
| ⊣ US1881LSO | ⊗ US1A-13-F | D US1A-E3/5AT | ⇒ US1A-E3/5AT | ↔ US1A-E3/61T |
| ⊗ US1A-E3/61T | ⊣ US1A-M3/61T | ⊗ US1A-M3/61T | ↔ US1AHE3/5AT | ↔ US1AHE3/5AT |
| D US1AHE3/61T | ⊗ US1AHE3/61T | ⊣ US1B-13-F | ⊗ US1B-E3/5AT | ↔ US1B-E3/5AT |
| ⇒ US1B-E3/61T | ↔ US1B-E3/61T | ⊗ US1B-M3/61T | ⊣ US1B-M3/61T | ↔ US1BHE3/5AT |
| ↔ US1BHE3/61T | ⇒ US1BHE3/61T | D US1C-E3/61T | ⊗ US1D-13-F | ⊣ US1D-E3/61T |
| ⊗ US1D-E3/61T | D US1D-M3/61T | ⇒ US1D-M3/61T | ↔ US1DWF-7 | ↔ US1DWF-7 |
| ⊣ US1G-13-F | ⊗ US1G-E3/61T | ↔ US1G-E3/61T | ⇒ US1G-M3/61T | ↔ US1G-M3/61T |
| ⊗ US1G/11T | ⊣ US1GHE3/5AT | ⊗ US1GHE3/5AT | D US1GHE3/61 | ↔ US1GHE3/61T |
| ↔ US1GHE3/61T | ⊗ US1GHE3_A/H | ⊣ US1GHE3_A/H | ⊗ US1GWF-7 | ↔ US1GWF-7 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited